



سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۶

زبان عمومی و تخصصی

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes the blank. Then mark the correct choice on your answer sheet.

۱- Lawyers for both parties will convene this morning to see if a can be reached before the matter reaches the court.

- 1) transparency 2) realism 3) settlement 4) discipline

۲- Later he her daughter for having talked to her teacher impolitely.

- 1) prevented 2) scolded 3) restricted 4) neglected

۳- The volcano had remained for over a hundred years, and most people thought it would never burst again.

- 1) dormant 2) drastic 3) severe 4) incidental

۴- You will certainly your sprained ankle if you attempt to play basketball today.

- 1) coerce 2) avoid 3) discomfit 4) exacerbate

۵- My medical condition is and cannot be altered even with medication.

- 1) immutable 2) exhaustible 3) durable 4) demanding

۶- The comedian hoped his jokes would a great deal of laughter from the audience.

- 1) pursue 2) explode 3) necessitate 4) elicit

۷- Because Kelly's parents were not affectionate, she grew up suffering from a/an of love and affection.

- 1) isolation 2) malfunction 3) violation 4) deprivation

۸- Although we may never completely every disease on earth, it's heartening to see the progress medicine has made on so many fronts.

- 1) overlook 2) eradicate 3) suspend 4) forecast

۹- As people mature, their skills become more developed, so they are capable of solving more complex problems.

- 1) collective 2) sufficient 3) cognitive 4) hypothetical

۱۰- I wonder why Cathy spends so much time telling me facts that have nothing to do with me.

- 1) curious 2) identical 3) irrelevant 4) unequivocal

PART B: Cloze Passage

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

The job of theoretical physicists is twofold: first, to explain what our experimental colleagues have discovered; and second, (11)..... phenomena that have not yet (12)..... . The history of scientific discovery shows that progress is achieved using (13)..... .

Quantum theory, for example, was largely driven by empirical results, (14)..... Einstein's general theory of relativity was (15)..... speculation and thought experiments, as well as advanced mathematics.

۱۱- 1) to predict 2) predicting 3) it is to predict 4) predict

۱۲- 1) found 2) to be found 3) been found 4) be found

۱۳- 1) both the methods 2) both methods 3) both of methods 4) methods both

۱۴- 1) as though 2) in that 3) so that 4) whereas

۱۵- 1) a product of 2) produced 3) production of 4) producing

**Part C: Reading Comprehension**

Directions: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

Passage 1:

Giant magneto-resistance (GMR) is a quantum mechanical magneto-resistance effect observed in thin-film structures composed of alternating ferromagnetic and non-magnetic conductive layers. The effect is observed as a significant change in the electrical resistance depending on whether the magnetization of adjacent ferromagnetic layers is in a parallel or an anti-parallel alignment. The overall resistance is relative for parallel alignment and relatively high for anti-parallel alignment. The magnetization direction can be controlled for example, by applying an external magnetic field. The effect is based on the dependence of electron scattering on the spin orientation. GMR in films was first observed by Fert and Gruenberg in a study of super-lattices composed of ferromagnetic and anti-ferromagnetic layers. The main application of GMR is magnetic field sensors, which are used to read data in hard disk drives. GMR multilayer structures are also used in magneto resistive random-access memory (MRAM) as cells that store one bit of information.

A cell of magneto resistive random-access memory (MRAM) has a structure similar to the spin-valve sensor. The value of the stored bits can be encoded via the magnetization direction in the sensor layer; it is read by measuring the resistance of the structure. The advantages of this technology are independence of power supply (the information is preserved when the power is switched off owing to the potential barrier for reorienting the magnetization), low power consumption and high speed.

In a typical GMR-based storage unit, a CIP structure is located between two wires oriented perpendicular to each other. These conductors are called lines of rows and columns. Pulses of electric current passing through the lines generate a vortex magnetic field, which affects the GMR structure.

☞ 16- According to the passage, what is the justification for the designation GMR?

- 1) The large magnetic field required to change the resistance of the sensor.
- 2) The complex underlying physics of resistance change in sensors.
- 3) The big size of the magnetic sensors.
- 4) The resistance change produced in response to a magnetic field.

☞ 17- According to the passage, which of the items below can be considered as a major application of the GMR sensor?

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1) Sensing magnet flux | 2) Sensing resistance |
| 3) Sensing thin film structure | 4) Sensing superlattice structures |

☞ 18- In the passage, the underlined word ‘oriented’ can best be replaced with

- | | | | |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| 1) turned | 2) lying | 3) twisting | 4) modified |
|-----------|----------|-------------|-------------|

☞ 19- Which of these component is not used in the structure of a GMR?

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1) Non-magnetic conductors | 2) Thin films |
| 3) Anti-ferromagnetic insulators | 4) Magnetic conductors |

☞ 20- What would be a good title for the passage?

- | | |
|---|---|
| 1) Giant Magneto Resistance theory | 2) Application of GMR in memories |
| 3) Measuring the resistance of structures | 4) Magnetic fields in quantum mechanics |

Passage 2:

Electrons play a fundamental role in electronics. They are commonly manipulated based on the two properties: charge and spin. Electronics has long exploited the charge of electrons to make devices that can turn on or off. More recently, we have also seen the spin of electrons leveraged. Encoding bits using the spin of electrons, instead of the usual charge is a promising potential for spintronic devices. Electron spin can be visualized as the rotation of an electron in one of two ways, with the rotation axis pointing up or down. Just as the presence or absence of an electric charge represents a bit equaling 1 or 0, a spin pointing up or down can do so as well. Flipping the spin to change a bit requires much less energy than moving charge. Spintronics has been held out as a way to greatly increase data processing speeds. However, quantum spin can be impacted by magnetic fields, which leads to stability problems for spintronics.



Both electronics and spintronics have their own strengths and weaknesses. Hence, researchers have focused on finding another degree of freedom in electrons that avoids those weaknesses and maximizes the strengths. Instead of relying on the electrons' spin or charge, valleytronics exploits their energy level in relation to their momentum. The "valley" in valleytronics comes from the shape of the graph you get when you plot the energy of electrons relative to their momentum: the resulting curve features two valleys. Electrons move through the lattice of a 2D semiconductor as a wave populating these two valleys, with each valley being characterized by a distinct momentum and quantum valley number. The trick is to manipulate these two valleys so that one is deeper than the other, which causes the electrons to populate one valley more than the other. When the electrons are in a minimum energy valley, the quantum valley number associated with it can be used to encode information.

☞ 21- The passage mainly talks about

- 1) Recent developments in electronics
- 2) Traditional transistors
- 3) The strengths and weaknesses of valleytronics
- 4) Quantum theory and its applications

☞ 22- One advantage of spintronics over electronics is

- 1) The orientation of electron charges
- 2) The requirement to move charges
- 3) Energy efficiency
- 4) The impact of magnetic fields on quantum spin

☞ 23- It can be inferred from the passage that

- 1) Changing electron population of valleys takes place at a lower energy level
- 2) Using electron charges is outdated these days
- 3) In valleytronics, the valleys are polarized
- 4) Data processing takes place faster with spintronics

☞ 24- Which characteristic distinguishes valleys from each other?

- 1) Electron spin
- 2) Momentum
- 3) Encoded information
- 4) Graph shape

☞ 25- Encoding bits in the three systems discussed in the passage does NOT take place in

- 1) Electron spins
- 2) Valley
- 3) Binary digits
- 4) Electron charges

Passage 3:

Telecommunications corporations are faced with increasing load on the connectivity service providers (CSP) networks due to rapid growth in the use of internet of thing (IoT) devices. In most applications, the CSP role is confined to providing the network access (e.g., SIM cards) and a long-term data plan. As traffic becomes more unpredictable, CSPs have little visibility into devices, applications or management of machine-generated traffic impacting their ability to deliver the appropriate quality of service (QoS).

At the enterprise level, business units struggle to implement and capitalize on the promise of IoT by extending or strengthening their activities by adding a telecommunications link to and from some of the products that they sell. Municipalities often have several agencies (e.g., Police, Transport, Tourism, IT and Infrastructure) wishing to deploy devices and sensors into the city to provide new services to the citizens, optimize their operations or reduce costs. Unfortunately, these different units work in isolation from each other, by focusing on their own vertical needs. This hinders efficient development and operations, as it leads to high development costs, little commonality, and little reusability in essence creating custom solutions for each vertical.

With the rapid development of opportunities in the IoT marketplace, organizations are challenged in developing business-specific solutions while ensuring maximum reusability across their organization and business units.

Fragmentation in the IoT industry, rooted in disparate devices and applications built on proprietary protocols can stifle innovation. This complex ecosystem makes it harder for application developers to innovate and create new applications cost effectively. In the Telco, enterprise, and municipal space, the effects of this complexity are felt in different ways.

☞ 26- The underlined word 'disparate' in the last paragraph means

- 1) Different
- 2) Opposite
- 3) Reusable
- 4) Manufactured

☞ 27- According to the text, what does IoT motivate at the enterprise level?

- 1) To increase the load on connectivity service providers
- 2) To make municipalities have a stronger role in providing the QoS in telecommunications services
- 3) To increase the number of SIM cards
- 4) To equip devices with communication capabilities

☞ 28- We may conclude from the passage that

- 1) QoS can be improved by multiplication of IoT devices
- 2) Fragmentation in the IoT facilitates innovations
- 3) Innovation is hampered by exclusive rights and natures of IoT protocols
- 4) An efficient deployment of the network may result from agencies focusing on their vertical needs



۲۹- CSPs lost in their service quality due to

- 1) Reduced visibility of CSPs
- 2) Efforts by telecommunications corporations to reduce cost
- 3) Rapid growth of IoT
- 4) Increasing load of CSP networks

۳۰- What is meant by ‘custom solution’ in the third paragraph?

- 1) Those conventionally used in IT problems
- 2) Those uniting otherwise isolated agencies
- 3) Those addressing the commonalities of IoT applications
- 4) Those addressing specific verticals

ریاضیات (معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی، آمار و احتمالات)

$$\text{که ۳۱- جواب معادله } \left[y + \frac{1}{\sqrt{y^2 - x^2}} \right] dx + \left[x - \frac{x}{y\sqrt{y^2 - x^2}} \right] dy = 0 \text{ در ناحیه } y > 0, \text{ کدام است؟}$$

$$\frac{x}{y} - \sin^{-1}\left(\frac{x}{y}\right) = c \quad (۴) \quad xy + \sin^{-1}(xy) = c \quad (۳) \quad xy + \sin^{-1}\left(\frac{x}{y}\right) = c \quad (۲) \quad \frac{x}{y} + \sin^{-1}\left(\frac{x}{y}\right) = c \quad (۱)$$

که ۳۲- در مسئله مقدار اولیه $y(0) = b > 0$ ، $y'' + 4y' + y = 0$ ، نقطه اکسترمم منحنی جواب، و نوع اکسترموم (ماکزیمم یا مینیمم) کدام است؟

$$(t_M, y_M) = \left(\frac{-2b}{2b+1}, (1+2b)e^{\frac{-2b}{2b+1}} \right) \quad (۳) \quad \text{نقطه ماکزیمم منحنی جواب} \quad (t_M, y_M) = \left(\frac{-2b}{2b+1}, (1+2b)e^{\frac{-2b}{2b+1}} \right) \quad (۱)$$

$$(t_M, y_M) = \left(\frac{-2b}{2b+1}, (1+b)e^{\frac{-2b}{2b+1}} \right) \quad (۴) \quad \text{نقطه مینیمم منحنی جواب} \quad (t_M, y_M) = \left(\frac{-2b}{2b+1}, (1+b)e^{\frac{-2b}{2b+1}} \right) \quad (۳)$$

که ۳۳- جواب عمومی معادله ناهمگن $x^2y'' - 3xy' + 4y = x^2 \ln x$ و $x > 0$ ، کدام است؟

$$y(x) = \frac{x^2}{\varsigma} (\ln x)^3 + C_1 x^2 \ln x + C_2 x^2 \quad (۲) \quad y(x) = \frac{x^2}{\varsigma} (\ln x)^3 + C_1 x \ln x + C_2 x^2 \quad (۱)$$

$$y(x) = \frac{x^2}{\varsigma} (\ln x) + C_1 x^2 \ln x + C_2 x^2 \quad (۴) \quad y(x) = \frac{x^2}{\varsigma} (\ln x)^2 + C_1 x^2 \ln x + C_2 x^2 \quad (۳)$$

که ۳۴- پاسخ معادله $xy'' - xy' - y = 0$ با شرایط $y(0) = 2$ و $y'(0) = 0$ ، کدام است؟

$$y = 2xe^{-x} \quad (۴) \quad y = 2xe^x \quad (۳) \quad y = 2xe^{-2x} \quad (۲) \quad y = 2xe^{2x} \quad (۱)$$

که ۳۵- جواب عمومی دستگاه معادلات $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} x' = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} x$ کدام است؟

$$x = C_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} e^{-t} + C_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-t} \quad (۲) \quad x = C_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} e^{-t} + C_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{3t} \quad (۱)$$

$$x = C_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \end{bmatrix} e^{-t} + C_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} e^{3t} \quad (۴) \quad x = C_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \end{bmatrix} e^{-t} + C_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} e^{-t} \quad (۳)$$

که ۳۶- فرض کنیم $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < L \\ 0, & -L < x < 0 \end{cases}$ کدام است؟

$$1 - \frac{L}{\pi} + \frac{2L}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} \cos \frac{(2k-1)\pi x}{L} - \frac{L}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k} \sin \frac{k\pi x}{L} \quad (۱)$$

$$1 - \frac{L}{\pi} - \frac{2L}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} \cos \frac{(2k-1)\pi x}{L} - \frac{L}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k} \sin \frac{k\pi x}{L} \quad (۲)$$

$$\frac{1}{2} - \frac{L}{\pi} + \frac{2L}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} \cos \frac{(2k-1)\pi x}{L} + \frac{L}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k} \sin \frac{k\pi x}{L} \quad (۳)$$

$$1 - \frac{L}{\pi} + \frac{2L}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} \cos \frac{(2k-1)\pi x}{L} + \frac{L}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k} \sin \frac{k\pi x}{L} \quad (۴)$$

پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۶

زبان عمومی و تخصصی

۱- گزینه «۳» و کلای هر دو طرف امروز صبح تشکیل جلسه خواهند داد تا بررسی کنند، قبل از اینکه پرونده به دادگاه ارجاع داده شود، توافقی به دست می‌آید.

- (۱) شفافیت (۲) واقع‌گرایی - واقع‌بینی (۳) توافق - حل و فصل (۴) انضباط - رشته تحصیلی

۲- گزینه «۲» بعدها او دخترش را به‌حاطر بد صحبت کردن با معلمش سرزنش کرد.

- (۱) مانع شدن - جلوگیری کردن (۲) سرزنش کردن - نکوهیدن (۳) محدود کردن (۴) غفلت کردن

۳- گزینه «۱» آتشفسان مدت یک‌صد سال خاموش بود و بسیاری از مردم تصور می‌کردند هیچگاه دوباره فوران نخواهد کرد.

- (۱) خاموش - خفت - غیر فعال (۲) شدید - مفرط (۳) شدید - سخت (۴) ضمنی

۴- گزینه «۴» اگر امروز بسکتبال بازی کنی، مطمئناً قوزک پای رگ به رگ شدهای را بدتر خواهی کرد.

- (۱) مجبور کردن - وادار کردن (۲) خودداری کردن (۳) بدتر کردن - وخیم کردن - شدید کردن (۴) به هم زدن - مختل کردن

۵- گزینه «۱» وضعیت پژوهشی من تغییرناپذیر است و حتی با دارو هم تغییر نخواهد کرد.

- (۱) تغییرناپذیر - دگرگون نشدنی (۲) تحلیل‌رفتنی - تمام‌شدنی (۳) بادوام - پایا (۴) سخت - پرزنمت

۶- گزینه «۴» کمدین امیدوار بود که لطیفه‌هایش موجب خنده مخاطبان (تماشاگران) شود.

- (۱) ادامه دادن - تعقیب کردن (۲) منفجر کردن - ترکیدن (۳) لازم کردن - مستلزم بودن (۴) موجب شدن - باعث شدن

۷- گزینه «۴» از آنجا که والدین کلی مهریان و عاطفی نبودند، او با رنج محرومیت از عشق و محبت بزرگ شد.

- (۱) تنهایی - انزوا (۲) خرابی - عیب (۳) بی‌حرمتی - قانون‌شکنی (۴) محرومیت - کمبود

۸- گزینه «۲» اگرچه ما هرگز به‌طور کامل (تمام و کمال) نمی‌توانیم هر بیماری را در دنیا ریشه‌کن کنیم، بسیار شفافانگیز (امیدوارکننده) است که می‌بینیم علم پژوهشی در بسیاری از جوانب پیشرفت داشته است.

- (۱) از بالا نگربستن - سرپرستی کردن (۲) ریشه‌کن کردن - نابود کردن (۳) پیش‌بینی کردن (۴) به تعویق اندختن - به تعلیق درآوردن

۹- گزینه «۳» هنگامی که مردم به سن بلوغ می‌رسند، مهارت‌های شناختی (ادراکی) آنها بیشتر توسعه می‌باید، بنابراین آنها قادر به حل مسائل پیچیده‌تری خواهند شد.

- (۱) همگانی - جمعی (۲) کافی - بس (۳) شناختی - ادراکی (۴) فرضی - گمانی

۱۰- گزینه «۳» نمی‌دانم که چرا آنقدر زمان صرف می‌کند تا نکات بی‌ربطی که بهدرد من نمی‌خورند را بگوید.

- (۱) کنجکاو - فضول (۲) همانند - یکسان (۳) بی‌ارتباط - نامرتب (۴) صریح - خالی از ابهام

ترجمه متن:

وظیفه فیزیکدانان نظری دو لایه (دوچندان) است. اول این که شرح دهنده همکاران تجربی ما چه چیز را کشف کرده‌اند و دوم پدیده‌هایی را که هنوز یافت نشده‌اند، پیش‌بینی کنند. تاریخچه اکتشافات علمی نشان می‌دهد که پیشرفت با استفاده از هر دو روش به دست می‌آید. برای مثال، کوانتون نظری عمده‌ای از نتایج نظری به‌دست آمده است. در حالی که نظریه کلی نسبیت انسیتین حاصل تعمق، تفکر، تجارب و همچنین ریاضیات پیشرفته است.

۱۱- گزینه «۱» تست بیانگر ساختار موازی است.

تذکر: ویرگول و and از نشانه‌های ساختار موازی هستند.

first to explain and second to predict



- ۱۲- گزینه «۳» find فعل متعدد است و در حالت معلوم با مفعول به کار می‌رود. از آنجا که در متن بعد از نقطه‌چین مفعول به کار نرفته است، لذا ساختار مجهول مدنظر است (to be p.p)، دلیل نادرست بودن گزینه (۱).
- تذکر ۱: ترکیب have not با گزینه (۳) ساختار مجهول در زمان حال کامل را می‌سازد.
- تذکر ۲: ترکیب have not با گزینه‌های (۲) و (۴) نادرست است.

- ۱۳- گزینه «۲» به دنبال پیش اسم both به معنی (هر دو - جفت) اسم به صورت جمع می‌آید.
- تذکر: طبق الگو داریم:

پیش اسم	+	اسم
both		methods
both of	+	ضمیر جمع
both of	+	پیش اسم
		اسم جمع +

- ۱۴- گزینه «۴» با توجه به مفهوم تست، گزینه‌های (۱) و (۲) و (۳) نادرست هستند. (برای مثال کوانتوم نظری از نتایج نظری به دست آمده است، در حالی که نظریه کلی نسبیت انسیتین حاصل تعمق و تفکر و... است).

(۱) انگار - گویی (۲) زیرا، از آنجا که (۳) به منظور اینکه (۴) در حالی که

- ۱۵- گزینه «۱» در تست فوق واژه product به معنی (حاصل - محصول - ثمره) اسم محسوب می‌شود و طبق الگو داریم:
- | | | | | | |
|---------|-----|-------------|----|---|-----|
| a | اسم | + | of | + | اسم |
| product | of | speculation | | | |
- تذکر: واژه production به معنی (تولید - محصول - فرآورده) نیز اسم است ولی با مفهوم تست همخوانی ندارد.

متن ۱:

مقاومت مغناطیسی بزرگ یا GMR، یک اثر مقاومت مغناطیسی مکانیکی کوانتومی است که در ساختارهای فیلم نازک متشکل از لایه‌های متناوب رسانای فرومغناطیسی و غیرمغناطیسی مشاهده می‌شود. این اثر به عنوان یک تغییر قابل توجه در مقاومت الکتریکی مشاهده شده است و بستگی دارد به این که آیا مغناطش لایه‌های فرومغناطیسی مجاور به صورت موازی و یا غیرموازی قرار گرفته است. مقاومت کلی برای چیدمان موازی نسبتاً کم و برای چیدمان غیرموازی نسبتاً بالا است. جهت مغناطش را می‌توان برای مثال با اعمال یک میدان مغناطیسی خارجی کنترل کرد. این اثر براساس واستگی الکترون‌ها است که طبق جهت اسپین پراکنده شده‌اند. GMR در فیلم برای اولین بار توسط فرت و گرونبرگ در یک مطالعه ابرشبکه‌ها متشکل از لایه‌های فرومغناطیسی و غیرمغناطیسی مشاهده شد. کاربرد اصلی GMR در حسگرهای میدان مغناطیسی است که برای خواندن داده‌ها در درایوهای هارد دیسک استفاده می‌شوند. ساختارهای چندلایه GMR نیز در حافظه مقاومت مغناطیسی با دسترسی تصادفی (MRAM) به عنوان سلول استفاده می‌شود که یک بیت از اطلاعات را ذخیره می‌کند.

یک سلول از حافظه مقاومت مغناطیسی با دسترسی تصادفی (MRAM) دارای ساختاری شبیه به حسگر چرخش سوپاپ است. ارزش بیت‌های ذخیره شده می‌تواند از طریق جهت مغناطش در لایه حسگر کددگاری شده و توسط اندازه‌گیری مقاومت ساختار خوانده شود. مزایای استفاده از این فناوری استقلال از منبع برق (زمانی که منبع خاموش است با وجود مانع بالقوه برای تغییر جهت مغناطش، اطلاعات حفظ می‌شود)، مصرف برق کم و سرعت بالا است. در یک واحد نوعی ذخیره‌سازی مبتنی بر GMR، یک ساختار CIP بین دو سیم که به صورت عمود بر هم واقع شده‌اند قرار گرفته است. این هادی‌ها خطوط سطرهای و ستونهای نامیده می‌شوند. پالس‌های جریان الکتریکی که از طریق خطوط عبور می‌کنند، یک میدان مغناطیسی گردابی تولید می‌کنند که بر ساختار GMR تأثیر می‌گذارد.

- ۱۶- گزینه «۴» طبق متن، کدامیک از گزینه‌ها توجیهی برای طراحی GMR است؟
- ۱) میدان مغناطیسی بزرگ مورد نیاز برای تغییر مقاومت حسگر
 - ۲) فیزیک اصولی پیجیده مقاومتی که در حسگرها تغییر می‌کند.
 - ۳) اندازه بزرگ حسگرهای مغناطیسی
 - ۴) تغییر مقاومتی که در پاسخ به یک میدان مغناطیسی تولید می‌شود.
- در پاراگراف اول متن، در مورد "... Significant change in the electrical resistance " صحبت کرده و اساس طراحی GMR را تغییر مقاومت در شرایط مختلف میدان مغناطیسی عنوان کرده است که همان گزینه (۴) می‌باشد.

- ۱۷- گزینه «۱» طبق متن، کدامیک از موارد زیر می‌تواند به عنوان یکی از کاربردهای حسگر GMR در نظر گرفته شود؟
- ۱) حس کردن میدان مغناطیسی
 - ۲) حس کردن مقاومت
 - ۳) حس کردن ساختار فیلم نازک
- طبق متن پاراگراف اول، "... The main application " کاربرد اصلی GMR را در حسگرهای میدان مغناطیسی عنوان کرده است. بنابراین گزینه (۱) صحیح است.

- ۱۸- گزینه «۲» بهترین جاگزین برای oriented که در متن زیر آن خط کشیده شده است، کدام گزینه است؟
- ۱) پیچیده شده
 - ۲) خوابیدن (کنارهم قرار گرفتن)
 - ۳) پیچیدن
 - ۴) اصلاح شده
- با توجه به اینکه oriented در اینجا به معنی در «جهت داده شده» است و برای نشان دادن جهت عمود برهم دو سیم استفاده شده است، کلمه Lying به معنی «خوابیدن (کنار هم قرار گرفتن)» دو سیم به جواب نزدیکتر است.

- ۱۹- گزینه «۳» کدام یک از تجهیزات زیر در ساختار یک GMR استفاده نمی‌شود؟
- ۱) هادی‌های غیرمغناطیسی
 - ۲) فیلم‌های نازک
 - ۳) عایق‌های غیر فرومغناطیسی
 - ۴) هادی‌های مغناطیسی
- در ابتدای پاراگراف اول به non-magnetic thin-films اشاره شده اما گزینه (۳) در متن وجود ندارد.

- ۲۰- گزینه «۲» کدام یک از گزینه‌ها می‌تواند یک عنوان خوب برای این متن باشد؟
- ۱) نظریه مقاومت مغناطیسی بسیار بزرگ
 - ۲) کاربرد GMR در حافظه‌ها
 - ۳) اندازه‌گیری مقاومت ساختارها
 - ۴) میدان‌های مغناطیسی در مکانیک کوانتوم
- در انتها پاراگراف اول به کاربرد GMR در حافظه‌ها اشاره کرده و در واقع نتیجه پاراگراف اول رسیدن به این مطلب است. در پاراگراف دوم نیز در مورد حافظه‌ها صحبت کرده است. بنابراین گزینه (۲) (کاربرد GMR در حافظه‌ها) صحیح است.

متن ۲:

الکترون‌ها نقشی اساسی را در علم الکترونیک بازی می‌کنند. آن‌ها معمولاً براساس دو ویژگی مورد استفاده قرار می‌گیرند: بار و چرخش. علم الکترونیک برای مدت طولانی بار الکترون‌ها را برای ساختن دستگاه‌هایی که بتوانند خاموش یا روشن شوند مورد استفاده قرار داده است. اخیراً دیده‌ایم که چرخش الکترون نیز (به عنوان ابزاری قوی) مورد استفاده قرار گرفته است. رمزگذاری بیت‌ها با استفاده از چرخش الکترون‌ها به جای بار معمول، یک امید بالقوه برای دستگاه‌های اسپینترونیک است. اسپین الکtron می‌تواند به عنوان چرخش الکترون در یکی از دو جهت، با محور چرخش به سمت بالا یا پایین باشد. از آنجایی که حضور یا عدم حضور یک بار الکترونیکی نمایش‌دهنده یک بیت برای با ۰ یا ۱ است، چرخش در جهت بالا یا پایین نیز می‌تواند این کار را انجام دهد. تغییر جهت چرخش الکترون برای تغییر یک بیت نیاز به انرژی بسیار کمتری از جابه‌جایی بار دارد. اسپینترونیک به عنوان یک روش برای افزایش بسیار زیاد سرعت پردازش داده‌ها بسط یافته است. با این حال، چرخش کوانتومی می‌تواند از میدان‌های مغناطیسی تأثیر بپذیرد که منجر به مشکلات پایداری برای اسپینترونیک می‌شود. الکترونیک و اسپینترونیک هر دو نقاط قوت و ضعف خود را دارند. از این رو محققان بر روی درجه دیگری از آزادی در الکترون‌ها متمرکز شده‌اند که از آن نقاط ضعف اجتناب کرده و نقاط قوت را به حداکثر برسانند. valleytronics به جای تکیه بر چرخش یا بار الکترون، از (نمودار) سطح انرژی الکترون‌ها برحسب تکانه آن‌ها استفاده می‌کند. «دره» در valleytronics از شکل نمودار انرژی الکترون‌ها زمانی که آن را برحسب تکانه الکترون‌هارسم می‌کنید، می‌آید: منحنی حاصل دارای دو دره است. الکترون‌ها از طریق شبکه یک نیمه‌هادی دو بعدی که به عنوان یک موج این دو دره را پر می‌کند، حرکت می‌کنند و هر دره توسط یک تکانه و شماره دره کوانتومی متمایز مشخص می‌شود. ترفندهای این است که این دو دره طوری دستکاری شوند که یکی عمیق‌تر از دیگری شود که باعث می‌شود جمعیت الکترون‌ها در یک دره بیش از دیگری باشد. هنگامی که الکترون‌ها در دره با انرژی کمتر هستند، شماره دره کوانتومی متناظر با آن می‌تواند برای رمزگذاری اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد.

- ۲۱- گزینه «۱» موضوع اصلی این متن کدام گزینه است؟
- ۱) توسعه‌های اخیر در الکترونیک
 - ۲) ترانزیستورهای قدیمی
 - ۳) نقاط قوت و ضعف Valleytronic
 - ۴) نظریه کوانتوم و کاربردهای آن
- با مطالعه کلی متن، خصوصاً با توجه به دو خط اول، می‌توان دریافت که موضوع اصلی متن گزینه (۱) (توسعه‌های اخیر در الکترونیک) است.

- ۲۲- گزینه «۳» کدام گزینه از مزایای اسپینترونیک نسبت به الکترونیک است؟
- ۱) جهت بارهای الکترون
 - ۲) نیاز به جابه‌جایی بارها
 - ۳) بازدهی انرژی
 - ۴) تأثیر میدان‌های مغناطیسی بر چرخش کوانتومی
- با توجه به پاراگراف اول، "Flipping ... much less energy"، راندمان انرژی در اسپینترونیک بیشتر است.

- ۲۳- گزینه «۴» طبق متن می‌توان این طور استنتاج کرد که:
- ۱) تغییر تعداد الکترون‌های درجه‌ها در یک سطح انرژی پایین تر انجام می‌شود.
 - ۲) امروزه استفاده از بارهای الکترون منسخ شده است.
 - ۳) در Valleytronics دره‌ها قطبیده می‌شوند.
- با توجه به "Spintronics ... increase data processing speeds" سرعت پردازش داده‌ها در اسپینترونیک بیشتر است. بنابراین گزینه (۴) صحیح است.

- ۲۴- گزینه «۲» کدام مشخصه دره‌ها را از هم تمایز می‌دهد؟
- ۱) اسپین الکترون
 - ۲) تکانه
 - ۳) اطلاعات رمزگذاری شده
 - ۴) شکل گراف
- طبق پاراگراف دوم "each valley ... a distinct momentum and quantum valley number" هر valley دارای تکانه و شماره منحصر به فرد است که در گزینه‌ها به تکانه اشاره شده است.



۲۵- گزینه «۳» رمزگذاری بیت‌ها در سه سیستم مورد بحث در متن در کدام گزینه اتفاق نمی‌افتد؟

۱) اسپین‌های الکترون‌ها

۲) دره عدهای دو دویی

در متن به سه سیستم رمزگذاری بیت‌ها اشاره کرده که در روش اول (electronics) از بارهای الکترون (Spintronics) از اسپین الکترون و در روش سوم (Valleytronics) از دره‌ها استفاده می‌شود. پس گزینه (۳) در هیچ‌کدام مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

متن ۳:

شرکت‌های مخابراتی با توجه به رشد سریع در استفاده از دستگاه‌های (دارای فناوری) اینترنت اشیا (IoT)، با افزایش بار بر روی شبکه‌های ارائه‌دهنده خدمات اتصال (CSP) مواجه شده‌اند. در اکثر کاربردها، نقش CSP به فراهم آوردن امکان دسترسی به شبکه (به عنوان مثال سیم‌کارت‌ها) و یک برنامه داده درازمدت محدود شده است. همان‌طور که ترافیک غیرقابل پیش‌بینی تر می‌شود، CSP‌ها دید محدودی به دستگاه‌ها، برنامه‌های کاربردی و یا مدیریت ترافیک ایجادشده توسط دستگاه دارند که این موضوع بر توانایی آن‌ها برای ارائه خدمات باکیفیت مناسب تأثیر می‌گذارد.

در سطح سازمان‌های اقتصادی، واحدهای کسب و کار در تلاش برای پیاده‌سازی و سرمایه‌گذاری بر روی وعده اینترنت اشیا به وسیله گسترش و یا تقویت فعالیت‌های خود با اضافه کردن یک لینک ارتباط از راه دور به و از برخی از محصولاتی که به فروش می‌رسانند، هستند.

شهرداری‌ها اغلب چندین سازمان دارند (به عنوان مثال پلیس، حمل و نقل، گردشگری، فناوری اطلاعات و زیرساخت) که مایل به استقرار دستگاه‌ها و حسگرها در شهر به منظور ارائه خدمات جدید به شهروندان، بهینه‌سازی عملیات‌های خود و یا کاهش هزینه‌ها هستند. متأسفانه این واحدهای مختلف به صورت مجزا از یکدیگر کار می‌کنند و تنها تمرکز بر نیازهای عمومی (شخصی) خود دارند. این امر مانع توسعه و عملیات کارآمد و منجر به هزینه‌های بالای توسعه، اشتراک کم، و قابلیت کم استفاده مجدد شده و در اصل باعث ایجاد راه حل‌های سفارشی برای هر واحد می‌شود.

با توسعه سریع فرصت‌ها در بازار اینترنت اشیا، سازمان‌ها در حال توسعه راه حل‌های کسب و کار خاص و در عین حال یک اطمینان حداکثری از قابلیت استفاده مجدد در سازمان‌ها و واحدهای کسب و کار خود هستند.

تکه‌تکه شدن در صنعت اینترنت اشیا که ریشه در دستگاه‌ها و برنامه‌های کاربردی مختلف ساخته شده بر روی پروتکل‌های اختصاصی دارد می‌تواند نوآوری را مختل کند. این اکوسیستم پیچیده شرایط را برای توسعه‌دهندگان نرم‌افزار برای نوآوری و ایجاد برنامه‌های جدید با هزینه مؤثر سخت‌تر می‌سازد. در شرکت‌های مخابراتی، تشکیلات اقتصادی و فضای شهری، اثرات این پیچیدگی از طرق مختلف احساس می‌شود.

۲۶- گزینه «۱» کلمه «disparate» در پارagraf آخر که زیر آن خط کشیده شده است، به چه معناست؟

۱) مختلف

۲) متنضاد

کلمه disparate به معنی «مختلف» است که مترادف Different می‌باشد.

۲۷- گزینه «۴» طبق متن، IoT باعث انگیزش چه چیزی در سطح اقتصادی می‌شود؟

۱) افزایش بار ارائه‌دهنگان خدمات اتصال

۲) وادار کردن شهرداری‌ها به داشتن نقشی مؤثرتر در ارائه کیفیت خدمات (QoS) در سرویس‌های مخابراتی

۳) افزایش تعداد سیم‌کارت‌ها

۴) تجهیز دستگاه‌ها با قابلیت‌های ارتباطی

در پارagraf دوم ”...At the enterprise“ به افزودن لینک مخابراتی (telecommunication link) به تولیدات اشاره شده است که متناسب با گزینه (۴) (تجهیز کردن تولیدات با قابلیت‌های ارتباطی) است.

۲۸- گزینه «۳» از متن نتیجه می‌گیریم که:

۱) کیفیت خدمات (QoS) می‌تواند با افزایش تجهیزات IoT بهبود یابد.

۲) جزءیه جزء شدن در نوآوری‌های تسهیلات IoT

۳) نوآوری توسط حقوق و طبیعت منحصر به فرد طبیعت پروتکل‌های IoT مختل شده است.

۴) گسترش کارآمد شبکه ممکن است در اثر نمایندگی‌هایی باشد که بر نیازهای شخصی خود تمرکز دارند.

در پارagraf آخر به این موضوع اشاره شده است که پروتکل‌های IoT می‌توانند باعث مختل کردن نوآوری شوند. (Fragmentation ... can stifle innovation.)

۲۹- گزینه «۲» IoT‌ها کیفیت خدمات رسانی‌شان را به دلیل از دست داده‌اند.

۱) میدان دید محدود IoT‌ها

۲) تلاش شرکت‌های مخابراتی برای کاهش هزینه‌ها

۳) افزایش بار شبکه‌های IoT

با مطالعه کلی متن این طور استنتاج می‌شود که تلاش شرکت‌های مخابراتی برای کاهش هزینه‌ها باعث می‌شود که کیفیت سرویس‌دهی IoT‌ها کاهش پیدا کند.

۳۰- گزینه «۴» معنای عبارت «custom solution» در پارagraf سوم چیست؟

۱) آن‌هایی که به صورت مرسم در مسائل IT استفاده می‌شوند.

۲) آن‌هایی که نمایندگی‌های مجزا را یکپارچه می‌کنند.

۳) آن‌هایی که مربوط به کاربردهای مشترک IoT هستند.

با توجه به پارagraf سوم خصوصاً خط آخر، custom solution مورد صحبت برای vertical است. بنابراین گزینه (۴) صحیح است.



(ریاضیات (معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی، آمار و احتمالات)

۳۱- گزینه «۲» معادله داده شده یک معادله‌ی کامل است، زیرا داریم:

$$\begin{cases} P(x,y) = y + (y^r - x^r)^{-\frac{1}{r}} \\ Q(x,y) = x - \frac{x}{y}(y^r - x^r)^{-\frac{1}{r}} \end{cases} \Rightarrow P_y = Q_x = 1 - y(y^r - x^r)^{-\frac{3}{r}}$$

حالا با انتگرال‌گیری از طرفین معادله و البته حذف جملات شامل x از Q می‌توانیم به جواب عمومی برسیم:

$$\int (y + \frac{1}{\sqrt{y^r - x^r}}) dx + \int (0 - 0) dy = 3 \Rightarrow yx + \sin^{-1}(\frac{x}{y}) = 3$$



۳۲- گزینه «۱» معادله‌ای همگن با ضرایب ثابت داریم. معادله‌ی مشخصه را می‌نویسیم:

$$y' = e^{-\frac{1}{r}t} (c_1 + c_2 t) \quad \text{ریشه‌های این معادله } r_1 = r_2 = -\frac{1}{r} \text{ هستند. جواب عمومی آن به صورت } y = c_1 e^{-\frac{1}{r}t} + c_2 t e^{-\frac{1}{r}t} \text{ است. پس داریم:}$$

$$y' = -\frac{1}{r} e^{-\frac{1}{r}t} (1 + c_2 t) + c_2 e^{-\frac{1}{r}t} \Rightarrow y'(0) = -\frac{1}{r} + c_2$$

چون $y(0) = 1$ است پس $c_1 = 1$ است. با محاسبه‌ی y' داریم:

$$\text{از صورت سؤال } b > 0 \text{ است پس } c_2 = \frac{1}{r} + b - \frac{1}{r} + c_2 = b \text{ است. با جایگذاری } c_1 \text{ و } c_2 \text{ داریم:}$$

$$y = e^{-\frac{1}{r}t} (1 + (b + \frac{1}{r})t) \Rightarrow y' = -\frac{1}{r} e^{-\frac{1}{r}t} (1 + (b + \frac{1}{r})t) + (b + \frac{1}{r}) e^{-\frac{1}{r}t} = e^{-\frac{1}{r}t} (b - \frac{1}{r}(b + \frac{1}{r})t)$$

$$y' = 0 \Rightarrow b - \frac{1}{r}(b + \frac{1}{r})t = 0 \Rightarrow t_M = \frac{rb}{b + \frac{1}{r}} = \frac{rb}{rb + 1} \quad \text{حالا نقطه‌ی اکسترموم را با حل } y' = 0 \text{ پیدا می‌کنیم:}$$

در ضمن با توجه به آنکه $e^{-\frac{1}{r}t}$ همواره مثبت است، علامت y' به علامت t بستگی دارد. ضریب t منفی است پس قبل از ریشه، مثبت و بعد از ریشه، منفی می‌شود. یعنی قبل از t_M ، علامت y' مثبت است و بعد از t_M علامت y' منفی است، پس محل نقطه‌ی ماقزیم است.



۳۳- گزینه «۲» یک معادله‌ی کوشی - اویلر (لزاندر مرتبه ۲) داریم. با تغییر متغیر $z = \ln x$ و معادله برحسب z به این صورت نوشته می‌شود:

$$r^r - 4r + 4 = 0 \Rightarrow r_1 = r_2 = 2$$

معادله مشخصه همگن را می‌نویسیم:

$$\Rightarrow y_h(z) = c_1 e^{rz} + c_2 z e^{rz} = c_1 x^r + c_2 x^r \ln x$$

$$y_p = \frac{1}{D^r - 4D + 4} (ze^{rz}) = \frac{1}{(D-2)^r} (ze^{rz})$$

برای تعیین y_p از روش عملگر معکوس استفاده می‌کنیم:

$$y_p = \frac{1}{F(D)} (ze^{rz}) = z \frac{1}{F(D)} (e^{rz}) - \frac{F'(D)}{F(r)} (e^{rz}) = z \frac{1}{F(D)} (e^{rz}) - \frac{r(D-2)}{(D-2)^r} (e^{rz})$$

$$= z \frac{1}{(D-2)^r} (e^{rz}) - \frac{r}{(D-2)^r} (e^{rz}) = z \frac{z^r}{r} (e^{rz}) - \frac{rz^r}{r!} (e^{rz}) = \frac{z^r}{r!} e^{rz}$$

$$y_p = \frac{x^r}{r!} (\ln x)^r \Rightarrow y = y_p + y_h = \frac{x^r}{r!} (\ln x)^r + c_1 x^r + c_2 x^r \ln x$$

با جایگذاری $z = \ln x$ داریم:



۳۴- گزینه «۳»

روش اول: با نگاه به گزینه‌ها می‌بینیم که جواب به صورت $y = 2xe^{ax}$ است. با محاسبه‌ی y' و y'' و جایگذاری در معادله داریم:

$$\begin{cases} y' = e^{ax} (2 + 2ax) \\ y'' = e^{ax} (2a + 2a + 2a^2 x) \end{cases} \Rightarrow xy'' - xy' - y = xe^{ax} (4a + 2a^2 x) - xe^{ax} (2 + 2ax) - 2xe^{ax} = 0$$

$$\Rightarrow e^{ax} [(2a^2 - 2a)x^2 + (4a - 4)x] = 0 \Rightarrow a = 1$$

پس $y = 2xe^x$ درست است.



سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۲

زبان عمومی و تخصصی

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or the phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet.

۱- Despite the fact that Gross Domestic Product (GDP) has increased substantially in the industrialized West, the levels of human contentment have remained

- 1) apposite 2) interwoven 3) static 4) implicit

۲- Immigration from the Latin word migration and means the act of a foreigner entering a country in the aim of obtaining the right of permanent residence.

- 1) gathers 2) obtains 3) arises 4) derives

۳- Not speaking the same language as your customers can lead to communication

- 1) breakdown 2) brevity 3) gesture 4) imitation

۴- The factory's workforce has from over 4,000 to a few hundred.

- 1) withdrawn 2) dwindled 3) undercut 4) forecasted

۵- The police came up empty-handed despite an exploration of the suspect's home.

- 1) exhaustive 2) inescapable 3) ephemeral 4) inevitable

۶- When the old man married a woman in her thirties, all everyone talked about was the in the couple's ages.

- 1) diversity 2) disparity 3) longevity 4) extension

۷- One local factory will the town's job shortage by providing 250 more jobs.

- 1) overlook 2) adjust 3) displace 4) alleviate

PART B: Cloze Passage

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

One commentator argues that the success of private schools is not in their money, (8) their organization. State schools fail their pupils because, under government control, they lack options. But if head teachers at state schools (9) given the same freedom as those at private schools, namely (10) poor teachers and pay more to good ones, parents would not need to send their children to private schools any more.

۸- 1) that is 2) it is in 3) but in 4) is

۹- 1) had 2) were 3) to be 4) be

۱۰- 1) by sacking 2) sacking 3) sacked 4) to sack

PART B: Cloze Passage

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

PASSAGE 1:

Internal combustion engines have thermodynamic limits on efficiency, expressed as a fraction of energy used to propel the vehicle compared to energy produced by burning fuel. Gasoline engines effectively use only 15% of the fuel energy content to move the vehicle or to power accessories; diesel engines can reach on-board efficiency of 20%; electric vehicles have efficiencies of 69-72%, when counted against stored chemical energy, or around 59-62%, when counted against required energy to recharge.

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{(1 - \frac{1}{2}e^{j\omega})(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega})}$$

که ۱۰۹- تبدیل فوریه سیگنال گستته $x[n]$ به صورت مقابل است:

مقدار x کدام است؟

$$\frac{5}{4} \quad (4)$$

$$\frac{5}{8} \quad (3)$$

$$\frac{5}{16} \quad (2)$$

$$\frac{5}{32} \quad (1)$$

الکترومغناطیس

که ۱۱۰- چگالی جریان الکتریکی حجمی در فضای خالی به صورت $\bar{J} = J_0 e^{-\frac{\rho}{a}} \hat{z}$ در دستگاه مختصات استوانه‌ای (ρ, φ, z) برقرار شده است. شدت میدان مغناطیسی \bar{H} در ρ کدام است؟

$$J_0 \left(\frac{a^2}{b} (1 - e^{-\frac{b}{a}}) - ae^{-\frac{b}{a}} \right) \hat{\varphi} \quad (2)$$

$$J_0 \left(\frac{a^2}{b} (1 - e^{-\frac{b}{a}}) + ae^{-\frac{b}{a}} \right) \hat{\varphi} \quad (1)$$

$$J_0 \left(a(1 - e^{-\frac{b}{a}}) + \frac{a^2}{b} e^{-\frac{b}{a}} \right) \hat{\varphi} \quad (4)$$

$$J_0 \left(a(1 - e^{-\frac{b}{a}}) - \frac{a^2}{b} e^{-\frac{b}{a}} \right) \hat{\varphi} \quad (3)$$

که ۱۱۱- از یک ماده عایق الکتریکی با ضریب گذردهی نسبی ۳ یک پوسته کروی به شعاع داخلی ۲cm و شعاع خارجی ۳cm ساخته‌ایم. انرژی لازم برای انتقال یک بار الکتریکی نقطه‌ای با مقدار $C = 2\mu$ از بینهاست به مرکز این پوسته کروی چند ژول است؟ $(\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9} \frac{F}{m})$

$$-0/4 \quad (4)$$

$$-0/8 \quad (3)$$

$$-0/2 \times 10^6 \quad (2)$$

$$-0/4 \times 10^6 \quad (1)$$

که ۱۱۲- در ناحیه‌ای از فضا میدان مغناطیسی \bar{B} غیرصفراست. بار آزمون q معلوم با دو سرعت v_1 و v_2 که بر هم عمودند در این میدان حرکت داده می‌شود و به ترتیب نیروی وارد بر بار آزمون \bar{F}_1 و \bar{F}_2 اندازه‌گیری می‌شود. میدان مغناطیسی \bar{B} کدام است؟

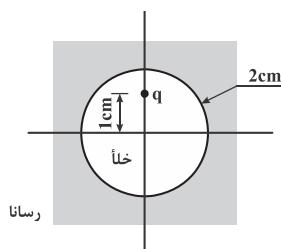
$$\frac{1}{q |v_1|^2 |v_2|^2} (\bar{F}_1 \times \bar{v}_1 + \bar{F}_2 \times \bar{v}_2) \quad (2)$$

$$\frac{1}{q} \left(\frac{1}{|v_1|^2} (\bar{F}_1 \times \bar{v}_1) + \frac{1}{|v_2|^2} (\bar{F}_2 \times \bar{v}_2) \right) \quad (1)$$

$$\frac{1}{q |v_2|^2} \left(\bar{F}_1 \times \bar{v}_2 + \frac{\bar{F}_1 \cdot (\bar{v}_2 \times \bar{v}_1)}{|v_1|^2} \bar{v}_2 \right) \quad (4)$$

$$\frac{1}{q |v_1|^2} \left(\bar{F}_1 \times \bar{v}_1 + \frac{\bar{F}_2 \cdot (\bar{v}_2 \times \bar{v}_1)}{|v_2|^2} \bar{v}_1 \right) \quad (3)$$

که ۱۱۳- در یک قطعه رسانا با ابعاد بینهاست یک حفره کروی به شعاع ۲cm ایجاد کردۀ‌ایم. در داخل این حفره همانند شکل در نقطه‌ای به فاصله ۱cm از مرکز حفره، بار نقطه‌ای به مقدار q قرار داده‌ایم. در این حالت پتانسیل الکتریکی در مرکز حفره یک ولت اندازه‌گیری شده است. اگر مقدار بار q دو برابر و فاصله آن تا مرکز نصف شود، پتانسیل الکتریکی در مرکز حفره چند ولت خواهد شد؟



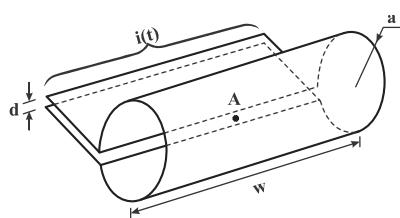
$$8 \quad (1)$$

$$6 \quad (2)$$

$$4 \quad (3)$$

$$3 \quad (4)$$

که ۱۱۴- فرض کنید جریان $i(t) = I_0 \sin \omega t$ آمپر به طور یکنواخت در پهنای یک نوار مسی نازک که عرض آن w است، همانند شکل جاری باشد. عرض نوار $w = 20\text{ cm}$ ، شعاع مسیر استوانه‌ای عبور جریان $a = 2\text{ cm}$ و فاصله d برابر 1 mm فرض می‌شوند. اگر $I_0 = 3\text{ A}$ و فرکانس جریان $i(t)$ برابر 1 kHz باشد، دامنه میدان الکتریکی در وسط دو صفحه در نقطه A بر حسب ولت بر متر کدام است؟



$$\mu_0 12\pi^3 \times 10^3 \quad (1)$$

$$\mu_0 6\pi \times 10^3 \quad (2)$$

$$\mu_0 12\pi^3 \times 10^6 \quad (3)$$

$$\mu_0 6\pi \times 10^6 \quad (4)$$

که ۱۱۵- در خلا دستگاه مختصات استوانه‌ای (ρ, φ, z) را در نظر بگیرید. ناحیه $2 < \rho < \rho$ تمی از بارهای الکتریکی است و روی سطح استوانه‌ای 2 تابع پتانسیل الکتریکی به صورت $\cos^2 \varphi$ به زاویه φ وابسته است. پتانسیل الکتریکی روی محور z بر حسب ولت کدام است؟

$$\frac{1}{3} \quad (4)$$

$$\frac{1}{2} \quad (3)$$

$$\frac{2}{3} \quad (2)$$

$$1 \quad (1)$$



کچه ۱۱۶—در خلا در داخل حجم مکعب $a \times a \times a$ و $|y| \leq a$ دوقطبی‌های مغناطیسی میکروسکوپی به طور یکنواخت به قسمی توزیع شده‌اند که بردار مغناطیسی شدگی در این حجم به صورت $\bar{M} = M_0 \hat{z}$ درآمده است. اندازه بردار شدت مغناطیسی یعنی $|\bar{H}|$ در نقطه $(x, y, z) = (0, 0, a)$ برابر ۲ آمپر بر متر اندازه‌گیری شده است. بردار میدان مغناطیسی \bar{B} در نقطه $(x, y, z) = (0, 0, -a)$ کدام است؟

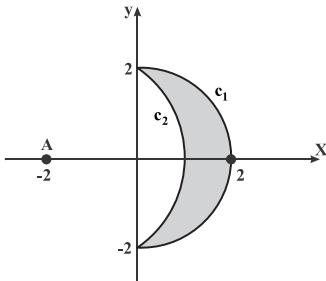
$$\mu_0(M_0 - 2)\hat{z} \quad (4)$$

$$\mu_0(M_0 + 2)\hat{z} \quad (3)$$

$$\mu_0 M_0 \hat{z} \quad (2)$$

$$\mu_0 2\hat{z} \quad (1)$$

کچه ۱۱۷—در خلا در صفحه xy بارهای الکتریکی با چگالی سطحی یکنواخت $\frac{1}{\sqrt{2}}$ کولن بر متر مربع در ناحیه هلالی همانند شکل توزیع شده‌اند. مرز c_1 دایره‌ای به شعاع ۲ متر و به مرکز مبدأ و مرز c_2 دایره‌ای به شعاع $\sqrt{2}$ متر و به مرکز نقطه A است. پتانسیل الکتریکی در نقطه A کدام است؟



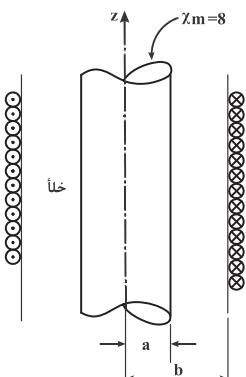
$$\frac{\sqrt{2}}{\epsilon_0} \left(\frac{1}{\pi} - \frac{1}{4} \right) \quad (2)$$

$$\frac{1}{\epsilon_0} \left(\frac{1}{\pi} - \frac{1}{4} \right) \quad (1)$$

$$\frac{\sqrt{2}}{\pi \epsilon_0} \quad (4)$$

$$\frac{1}{\pi \epsilon_0} \quad (3)$$

کچه ۱۱۸—شکل مقابل، یک سولنوئید بسیار بلند را نشان می‌دهد. تعداد حلقه‌های این سولنوئید در واحد طول بسیار زیاد و جهت جریان حلقه‌ها مطابق شکل فرض می‌شود. هسته سولنوئید و مشخصات آن در شکل ملاحظه می‌شود. اگر اندازه بردار پتانسیل مغناطیسی $|\bar{A}|$ در نقطه $\rho = a = 2\text{ mm}$ برابر ۳ وبر بر متر باشد، بردار پتانسیل مغناطیسی \bar{A} در نقطه $\rho = b = 4\text{ mm}$ بر حسب وبر بر متر کدام است؟



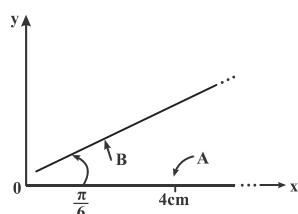
$$2\hat{\phi} \quad (4)$$

$$\frac{15}{7}\hat{\phi} \quad (3)$$

$$\frac{3}{2}\hat{\phi} \quad (2)$$

$$\frac{2}{3}\hat{\phi} \quad (1)$$

کچه ۱۱۹—دو نیم‌صفحه رسانا همانند شکل با یکدیگر زاویه $\frac{\pi}{4}$ می‌سازند و در مبدأ بدون اتصال الکتریکی به یکدیگر، به هم می‌رسند. این دو رسانا به منبع ولتاژ متصل شده‌اند. در نقطه A در شکل چگالی بارهای سطحی روی سطح بالایی رسانا ۲ کولن بر متر مربع است. در نقطه B که در فاصله ۳ cm از مبدأ است، بردار چگالی شار \bar{D} کدام است؟



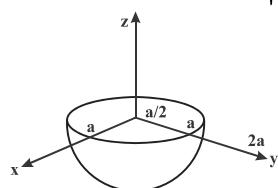
$$-\frac{2}{3}\hat{x} + \frac{2}{\sqrt{3}}\hat{y} \quad (2)$$

$$-\frac{4}{3}\hat{x} + \frac{4}{\sqrt{3}}\hat{y} \quad (1)$$

$$-\frac{1}{2}\hat{x} + \frac{\sqrt{3}}{2}\hat{y} \quad (4)$$

$$-\hat{x} + \sqrt{3}\hat{y} \quad (3)$$

کچه ۱۲۰—در خلا بر روی نیم‌کره نشان داده شده در شکل، بارهای الکتریکی با چگالی سطحی یکنواخت توزیع شده‌اند. شعاع نیم‌کره a بوده و مرکز آن بر مبدأ مختصات منطبق است. اگر پتانسیل الکتریکی در نقطه $(x, y, z) = (0, 2a, 0)$ برابر ۲ ولت باشد، پتانسیل الکتریکی در نقطه $(x, y, z) = (0, 0, a)$ کدام است؟



$$3 \quad (1)$$

$$4 \quad (2)$$

$$8 \quad (3)$$

$$16 \quad (4)$$

کچه ۱۲۱—در ناحیه کروی $a < r$ دوقطبی‌های میکروسکوپی مغناطیسی به طور یکنواخت در حجم توزیع شده‌اند به قسمتی که در این ناحیه بردار مغناطیسی شدگی \bar{M} برداری ثابت در جهت \hat{x} است. اگر اندازه بردار میدان مغناطیسی ناشی از این دوقطبی‌ها یعنی $|\bar{B}|$ در نقطه $(x, y, z) = (0, 0, a^-)$ برابر ۲ وبر بر متر مربع باشد، بردار میدان مغناطیسی \bar{B} در نقطه $(x, y, z) = (0, 0, a^+)$ بر حسب وبر بر متر مربع کدام است؟

$$4\hat{x} \quad (4)$$

$$2\hat{x} \quad (3)$$

$$-\frac{4}{3}\hat{x} \quad (2)$$

$$-\frac{2}{3}\hat{x} \quad (1)$$



پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۲

زبان عمومی و تخصصی

بخش اول: واژگان

دستور العمل: بهترین کلمه یا عبارت (۱)، (۲)، (۳) یا (۴) را برای کامل نمودن هر جمله انتخاب نمایید و سپس گزینه انتخاب شده را روی پاسخ برگ خود علامت بزنید.

۱- گزینه «۳» به رغم اینکه تولید ناخالص داخلی (GDP) به طرز چشمگیری در {کشورهای} صنعتی شده غربی افزایش یافته، سطح رضایت انسان ثابت و بی‌تغییر مانده است.

۱	apposite	بهجا، مناسب	۲	interwoven	درهم‌تنیده
۳	static	ثابت، ایستا، راکد	۴	implicit	ضمی، غیرمستقیم
	substantially	به میزان قابل توجهی		contentment	رضایت، خشنودی

۲- گزینه «۴» لغت migration از واژه لاتین مشتق شده و به این معناست: اقدام یک خارجی برای ورود به یک کشور با هدف اخذ حق اقامت دائم {آن کشور}.

۱	gather	جمع کردن، گردhem آمدن	۲	obtain	به دست آوردن
۳	arise	برخاستن، طلوع کردن	۴	derive from	مشتق شدن از
	permanent	دائمی		residence	اقامت

۳- گزینه «۱» صحبت نکردن به همان زبانی که مشتری‌های تان {صحبت می‌کنند} می‌تواند منجر به شکست در ارتباط شود.

۱	breakdown	خرابی، شکست	۲	brevity	اختصار، ایجاز
۳	gesture	رشت	۴	imitation	تقلید

۴- گزینه «۲» نیروی کار این کارخانه از بیش از ۴۰۰۰ نفر به چندصد نفر کاهش یافته است.

۱	withdraw	صرف‌نظر کردن، عقب کشیدن	۲	dwindle	کاهش یافتن، تحلیل رفتان
۳	undercut	زیر قیمت فروختن	۴	forecast	پیش‌بینی کردن

۵- گزینه «۱» پلیس به رغم وارسی و تفتیش کامل خانه فرد مظنون، دست خالی ماند (مدرک به درد بخوری پیدا نکرد)

۱	exhaustive	کامل و دقیق، جامع	۲	inescapable	اجتناب‌ناپذیر، گریزناپذیر
۳	ephemeral	زودگذر، موقتی	۴	inevitable	اجتناب‌ناپذیر

۶- گزینه «۲» وقتی آن پیرمرد با خانمی سی و خردۀ ساله ازدواج کرد، تمام آنچه دیگران ازش صحبت می‌کردند، اختلاف سنی این زوج بود.

۱	diversity	تنوع، گوناگونی	۲	disparity	اختلاف، ناهمخوانی
۳	longevity	طول عمر	۴	extension	بسط، گسترش

۷- گزینه «۴» یک کارخانه محلی خیال دارد کمبود شغل شهر را از طریق ایجاد ۲۵۰ شغل بیشتر، کاهش دهد (تسکین دهد).

۱	overlook	نادیده گرفتن	۲	adjust	تنظیم کردن
۳	displace	جایه‌جا کردن، جایگزین شدن	۴	alleviate	آرام کردن، تسکین دادن، کاستن
	shortage	کمبود		provide	تدارک دیدن، فراهم آوردن

Alleviate: to make something less painful or difficult to deal with

توضیح:

alleviate the problem/situation/suffering etc

a new medicine to alleviate the symptoms of flu



می دانیم:

$$Z(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} \xrightarrow{\text{جدول}} z[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

$$\Rightarrow \begin{cases} Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{j\omega}} \xrightarrow{\text{معکوس زمانی}} y[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{-n} u[-n] \\ W(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} \xrightarrow{\text{up-sampling}} w[n] = z_{(2)}[n] = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{n}{2}} u\left[\frac{n}{2}\right], & \text{مضرب } n \\ 0, & \text{o.w} \end{cases} \end{cases}$$

$$X(e^{j\omega}) = Y(e^{j\omega}) \cdot W(e^{j\omega}) \xrightarrow{\text{کانولوشن زمانی}} x[n] = y[n] * w[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} y[n-k] w[k]$$

$$\xrightarrow{n=\ell} x[\ell] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{-(\ell-k)} u[-(\ell-k)] \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{k}{2}} u\left[\frac{k}{2}\right] = \left(\frac{1}{2}\right)^{-\ell} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{k}{2}} u\left[\underbrace{k-\ell}_{=1, k \geq \ell}\right] u\left[\underbrace{k}_{=1, k \geq \ell}\right] = \left(\frac{1}{2}\right)^{-\ell} \sum_{k=\ell}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{k}{2}} = I$$

$$(3) \quad \text{مضرب } k$$

$$I = 16 \sum_{\ell=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{\ell} \left(\frac{1}{2}\right)^{\ell} = 16 \sum_{\ell=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{16}\right)^{\ell} = 16 \frac{\left(\frac{1}{16}\right)^1}{1 - \frac{1}{16}} = \frac{1}{15}$$

حال از تغییر متغیر $k = 3\ell$ استفاده می کنیم:

الکترومغناطیس

۱۱۰- گزینه «۲» ابتدا از رابطه قانون آمپر استفاده می کنیم. به این صورت که حلقه‌ای به شعاع r در نظر می گیریم و قانون آمپر را برای آن می نویسیم.

$$\oint H \cdot dl = I_{enc} = \int J_o da \quad (I)$$

حلقه‌ای به شعاع r در نظر می گیریم. به دلیل تقارن در r ثابت، H ثابت است.

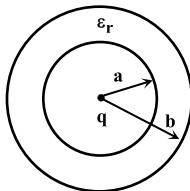
$$\xrightarrow{(I)} H \times 2\pi r = \iint J_o e^{-\frac{\rho}{a}} \rho d\phi d\rho = 2\pi J_o \int_{\rho=0}^r e^{-\frac{\rho}{a}} \rho d\rho \quad (II)$$

$$\xrightarrow{(II)} H \times 2\pi r = 2\pi J_o (\rho e^{-\frac{\rho}{a}} (-a)) \Big|_{\rho=0}^r - \int e^{-\frac{\rho}{a}} (-a) d\rho$$

$$\Rightarrow H \times r = J_o \left(-re^{-\frac{r}{a}} a + a \times (-a)(e^{-\frac{r}{a}} - 1) \right) \Rightarrow H = J_o \left(-\frac{a^2}{r} e^{-\frac{r}{a}} + \frac{a^2}{r} - ae^{-\frac{r}{a}} \right)$$

$$\xrightarrow{r=b} H(b) = J_o \left(-\frac{a^2}{b} e^{-\frac{b}{a}} + \frac{a^2}{b} - ae^{-\frac{b}{a}} \right)$$

۱۱۱- هیچ کدام از گزینه‌ها صحیح نیست. ابتدا با استفاده از قانون گاووس، بردار جابه جایی الکتریکی را در هر کدام از قسمت‌های فضا حساب می کنیم. سپس با استفاده از آن بردار میدان الکتریکی را در هر قسمت از فضا حساب می کنیم. در نهایت با استفاده از رابطه داده شده برای انرژی الکتریکی، انرژی الکتریکی را در کل فضا حساب می کنیم. فرض کنیم بار q در مرکز پوسته به شعاع داخلی a و خارجی b وجود داشته باشد.



فضا را به سه قسمت تقسیم می کیم

$$r < a$$

$$b < r$$

$$r < a : D \times 4\pi r^2 = q \Rightarrow \vec{D} = \frac{q}{4\pi r^2} \hat{r} \Rightarrow \vec{E} = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

$$a < r < b : D \times 4\pi r^2 = q \Rightarrow \vec{D} = \frac{q}{4\pi r^2} \hat{r} \Rightarrow \vec{E} = \frac{q}{4\pi \epsilon_r \epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

$$b < r : D \times 4\pi r^2 = q \Rightarrow \vec{D} = \frac{q}{4\pi r^2} \hat{r} \Rightarrow \vec{E} = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 r^2} \hat{r}$$



$$\begin{aligned} U_2 &= \frac{1}{2} \int_{\text{روی کل فضا}} \vec{E} \cdot \vec{D} dV = \frac{1}{2} \left[\int_0^a \epsilon_0 \frac{q^2}{(4\pi\epsilon_0)^2 r^4} \times 4\pi r^2 dr + \int_a^b \epsilon_r \epsilon_0 \frac{q^2}{(4\pi\epsilon_r \epsilon_0)^2} \times 4\pi r^2 dr + \int_b^\infty \frac{\epsilon_0 q^2}{(4\pi)^2 \epsilon^2 r^4} 4\pi r^2 dr \right] \\ &= \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0} \left[\int_0^a \frac{dr}{r^2} + \int_a^b \frac{dr}{\epsilon_r r^2} + \int_b^\infty \frac{dr}{r^2} \right] = \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0} \left[-\frac{1}{a} + \underbrace{\frac{1}{r}}_{\text{انرژی خلق}} \Big|_{r=a} + \frac{1}{4} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) + \frac{1}{b} \right] \end{aligned}$$

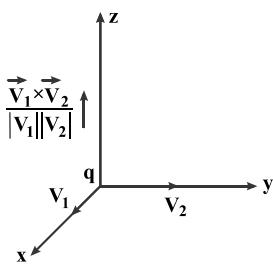
دقت کنید که عبارت $\left. \frac{1}{r} \right|_{r=a}$ خود انرژی نامتناهی ذره یا انرژی خلق ذره است که در صورت سؤال این را نخواسته است چرا که ذره خلق شده بود. پس این انرژی را کم می‌کنیم (در واقع اگر مقدار انرژی اولیه سیستم حول جایی که ذره است را بنویسیم همین مقدار می‌شود و چون کار برابر با اختلاف انرژی است، این مقدار را باید حتماً کم کنیم).

$$\Rightarrow U_1 = \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0} \left[-\frac{1}{a} + \frac{1}{4a} + \frac{1}{b} - \frac{1}{4b} \right] = \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0} \left(\frac{-4b + b + 4a - a}{4ab} \right) = \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0} \frac{(b-a)(1-4)}{4ab} \Rightarrow W = U_2 - U_1 = U_2$$

$$W = \frac{\cancel{4} \times 10^{-12}}{\cancel{4\pi} \times \frac{1}{\cancel{36\pi}} \times 10^{-9}} \times \frac{10^{-2} \times (-2)}{\cancel{4} \times \cancel{4} \times \cancel{4} \times 10^{-4}} = -2 \times 10^{-1} = -0.2$$

با جایگذاری اعداد داریم:

۱۱۲- گزینه «۳» می‌دانیم که نیروی وارد بر بار الکتریکی برابر است با $F = qV_B$. از این رابطه شروع می‌کنیم. در ادامه با استفاده از قاعده $BAC - CAB$ ، ضرب خارجی دوتایی را ساده می‌کنیم تا به جواب برسیم.



$$\vec{F}_1 = q \vec{V}_1 \times \vec{B} \Rightarrow \vec{F}_1 \times \vec{V}_1 = -q \vec{V}_1 \times (\vec{V}_1 \times \vec{B})$$

$$\vec{F}_2 = q \vec{V}_2 \times \vec{B} \Rightarrow \vec{F}_2 \times \vec{V}_2 = -q \vec{V}_2 \times (\vec{V}_2 \times \vec{B})$$

$$A \times (B \times C) = B(AC) - C(AB) : BAC - CAB$$

$$\Rightarrow \vec{F}_1 \times \vec{V}_1 = (-q)(\vec{V}_1(\vec{V}_1 \cdot \vec{B}) - \vec{B}(\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_1)) \quad , \quad \vec{F}_2 \times \vec{V}_2 = (-q)(\vec{V}_2(\vec{V}_2 \cdot \vec{B}) - \vec{B}(\vec{V}_2 \cdot \vec{V}_2))$$

$$B = (B_x, B_y, B_z)$$

$$\Rightarrow \vec{F}_2 \cdot (\vec{V}_2 \times \vec{V}_1) = q |\vec{V}_2|^2 B_z |\vec{V}_1|$$

$$\vec{F}_1 \times \vec{V}_1 = q |\vec{V}_1|^2 \vec{B} - q |\vec{V}_1|^2 \vec{B} \times \hat{X} = q |\vec{V}_1|^2 (B_y \hat{y} + B_z \hat{z})$$

$$\Rightarrow \frac{\vec{F}_1 \times \vec{V}_1}{|\vec{V}_1|^2} + \frac{\vec{F}_2 \cdot (\vec{V}_2 \times \vec{V}_1)}{|\vec{V}_2|^2 |\vec{V}_1|^2} \vec{V}_1 = q(B_y \hat{y} + B_z \hat{z}) + q B_z \hat{X} = q \vec{B}$$

۱۱۳- گزینه «۲» در هر دو حالت، پتانسیل کل برابر پتانسیل بار الکتریکی به علاوه پتانسیل بار القاشده روی پوسته داخلی در مرکز کرده است.

$$V_{\text{کل}} = V_q + V_{\text{پوسته}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \times 10^{-2}} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 \times 2 \times 10^{-2}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \times 10^{-2}} \left(\frac{1}{2} \right)$$

$$V_{\text{کل}} = V_q + V_{\text{پوسته}} = \frac{\cancel{4} 2q}{4\pi\epsilon_0 \times 0.5 \times 10^{-2}} + \frac{-\cancel{4} 2q}{4\pi\epsilon_0 \times 2 \times 10^{-2}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \times 10^{-2}} (4-1) = 3 \times \left(\frac{q}{4\pi\epsilon_0 \times 10^{-2}} \right)$$

$$\Rightarrow 6 \text{ برابر می‌شود}$$

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

$$\vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{J}(\vec{r}', t')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d^3 r'$$

۱۱۴- گزینه «۲» در حالت کلی داریم:

که ϕ پتانسیل الکتریکی است و \vec{A} پتانسیل برداری است که با رابطه مقابله داده می‌شود: که در رابطه فوق $(\vec{r}', t') \vec{J}$ چگالی جریان حجمی است پس کافی است \vec{A} را تعیین کنیم. با توجه به اینکه نقطه موردنظر A در وسط دو صفحه قرار دارد و جریان عبوری از دو صفحه در جهت مخالف یکدیگر است، از رابطه بالا دو صفحه سهم یکدیگر را در A حذف می‌کنند و نیازی به محاسبه آنها نیست. پس صرفأ سهم استوانه را محاسبه می‌کنیم. با توجه به اینکه گپ بین دو صفحه خیلی کوچکتر از شعاع و طول استوانه است برای راحتی محاسبه می‌توان آن را در محاسبات وارد نکرد و بنابراین محاسبه را تقریبی انجام می‌دهیم. پس فرض می‌کنیم استوانه کاملی داریم و چون طول استوانه خیلی بزرگتر از شعاع آن است در محاسبه \vec{A} از تقریب استوانه با طول بزرگ استفاده می‌کنیم.

